

Физика и техника полупроводников, 2024, том 58, выпуск 3

Горбенко И.В., Качоровский В.Ю.

Управление зонной структурой латерального плазменного кристалла магнитным полем*

115

Краснова И.А., Закиров Е.Р., Сидоров Г.Ю., Сабина И.В.

Низкотемпературные обработки поверхности CdHgTe методом PE-ALD перед осаждением HfO₂*

120

Чернышова Е.В., Росляков С.И., Ермакова Ж.С., Аргунов Е.В., Московских Д.О., Юдин С.Н., Ховайло В.В.

Термоэлектрические свойства перовскита CaMnO₃, синтезированного методом горения реакционных аэрозолей*

126

Неэлектронные свойства полупроводников (атомная структура, диффузия)

Лундин В.В., Заварин Е.Е., Сахаров А.В., Казанцев Д.Ю., Бер Б.Я., Цацульников А.Ф.

Исследование влияния условий роста на легирование GaN углеродом из пропана и метана

134

Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Чернов М.Ю., Соловьев В.А., Дричко И.Л., Смирнов И.Ю., Иванов С.В.

Влияние конструкции и условий роста метаморфных гетероструктур In(Ga,Al)As/GaAs на электрофизические параметры двумерного канала In_{0.75}Ga_{0.25}As/InAlAs

142

Физика полупроводниковых приборов

Шестериков А.Е., Шестерикова Д.А., Ерофеев Е.В.

Исследование конструктивно-технологических особенностей изготовления маломощных GaAs-транзисторов с длиной T-затвора 150 нм для систем передачи информации

149

Жидяев К.С., Чигинева А.Б., Байдусь Н.В., Самарцев И.В., Кудрин А.В.

Исследование влияния топологии полосковой мезаструктуры на основные параметры низковольтного GaAs-тиристора

156

Подоскин А.А., Шушканов И.В., Слипченко С.О., Пихтин Н.А., Багаев Т.А., Светогоров В.Н., Яроцкая И.В., Ладугин М.А., Мармалюк А.А., Симаков В.А.

Низковольтные токовые ключи на основе гетероструктур тиристоры Al-In-Ga-As-P/InP для импульсных лазерных излучателей (1.5 мкм) наносекундной длительности

161

Подоскин А.А., Шушканов И.В., Слипченко С.О., Пихтин Н.А., Багаев Т.А., Светогоров В.Н., Рябоштан Ю.Л., Ладугин М.А., Мармалюк А.А., Симаков В.А.

Гибридные сборки тиристорный ключ-полупроводниковый лазер на основе гетероструктур Al-In-Ga-As-P/InP для мощных импульсных источников лазерного излучения (1400-1500 нм)

165